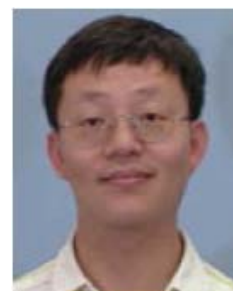


# 個 人 資 料 與 著 作

姓名：林兆焄  
 學號：8818802  
 系所：材料科學與工程研究所  
 出生日期：1964/03/01  
 連絡電話：0938-501313  
 電子郵件：[johnsonchlin@gmail.com](mailto:johnsonchlin@gmail.com)



(a) 學歷：

學 校 科 系	學 位	畢 業 年 月
國立臺灣科技大學機械(工程)	碩士畢業	1991/06/15
國立臺灣科技大學機械(工程)	學士畢業	1989/06/15

(b) 經歷：

服 務 機 關	產 品	職 級	任 職 起 訖 時 間
工業技術研究院 材料與化工研究所	R&D	工程師	起: 1991年9月
			迄: 2006年6月
東力電機公司	減速馬達/ 減速機	工程師	起: 1986年7月
			迄: 1986年12月

(c) 現職：

服 務 機 關	產 品	職 級	工 作 內 容
工業技術研究院 材料與化工研究所	R&D	工程師	太陽能電池用矽材 料之純化技術研究
中華民國粉末冶金協會	社會服務	副秘書長	協會會務

(d) 著作：

**Journal papers:**

1. C. T. Kuo, J. Y. Wu, **C. H. Lin**, T. R. Lu, C. M. Sung, “Internal stresses and microstructures of commercial thick diamond films deposited by different deposition methods”, Mater. Chemi. and Phys. 72 (2001) 114–120.
2. **C. H. Lin**, H. L. Chang and C. T. Kuo, “Growth mechanism and properties of the large area well-aligned carbon nanostructures deposited by microwave plasma electron cyclotron CVD”, Dia. Relat. Mater. 11

- (2002) 922-926.
3. H. L. Chang, **C. H. Lin** and C. T. Kuo, "Field emission, structure, cathodoluminescence and formation studies of carbon and Si-C-N nanotubes", *Dia. Relat. Mater.* 11 (2002) 793-798.
  4. C. M. Hsu, **C. H. Lin**, H. L. Chang and C. T. Kuo, "Growth of the large area horizontally-aligned carbon nanotubes by ECR-CVD", *Thin Solid Films* 420-421 (2002) 225-229.
  5. H. L. Chang, **C. H. Lin** and C. T. Kuo, "Iron and cobalt silicide catalysts-assisted carbon nanostructures on the patterned Si substrates", *Thin Solid Films* 420-421 (2002) 219-224.
  6. **C. H. Lin**, H. L. Chang, C. M. Hsu, A. Y. Lo, C. T. Kuo, "The role of nitrogen in carbon nanotube formation", *Dia. Relat. Mater.*, 12 (2003) 1851-1857.
  7. C. T. Kuo, **C. H. Lin** and A. Y. Lo, "Feasibility studies of magnetic particle-embedded carbon nanotubes for perpendicular recording media", *Dia. Relat. Mater.*, 12 (2003) 799-805.
  8. **C. H. Lin**, S. H. Lee, C. M. Hsu and C. T. Kuo, "Comparisons on properties and growth mechanisms of carbon nanotubes fabricated by high-pressure and low-pressure plasma-enhanced chemical vapor deposition", *Dia. Relat. Mater.*, 13 (2004) 2147-2151.
  9. C. M. Hsu, **C. H. Lin**, H. J. Lai, C. T. Kuo, "Root growth of multi-wall carbon nanotubes by MPCVD", *Thin Solid Films* 471 (2005) 140-144.
  10. S. H. Lee, **C. H. Lin**, J. M. Chiou, C. T. Kuo, "Effects of post treatment on the field emission properties of CNTs grown by ECR-CVD", *Dia. Relat. Mater.* (2005) (in press).

### Conference papers:

1. 蔡明和, **林兆焄**, 張惠林 和 郭正次, 2001年中華民國鍍膜科技研討會。
2. 郭正次、**林兆焄** 和 駱安亞, "鑲埋磁性顆粒之碳奈米管在垂直磁記錄媒體應用之可行性" 2002年中華民國粉末冶金年會, 粉末冶金會刊 (2002)
3. **C. H. Lin**, S. H. Lee, C. M. Hsu, M. H. Tsai and C. T. Kuo, "Electric

field induced carbon nanostructures for electronics and high surface area applications” 2003 MRS Spring Meeting ,Mat. Res. Soc. Symp. Proc. Vol. 776 (2003) Q11.11.1- Q11.11.6.

4. **林兆焄**, 李淑幸, 許智明 和 郭正次, “氮在碳奈米管生成所扮演的角色”, 2003年中華民國鍍膜科技研討會(2003)。

(e) 專利：

1. 郭正次, 張惠林, **林兆焄**, “選擇性沉積碳奈米結構於矽晶上之方法 (Method of selective growth of carbon nano-structures on Si substrates)”, 美國發明專利, 答辯中。
2. 郭正次, 許智明, 張惠林, **林兆焄**, “一種成長奈米管平行基材表面的方法 (Method of growing carbon nanotubes parallel to the substrate surface)”, 發明專利, 申請中。
3. 郭正次, 許智明, **林兆焄**, “一種製作場發射源的方法 (Method of fabricate field emitter source)”, 發明專利, 申請中。
4. 郭正次, 駱安亞, 駱伯遠, **林兆焄**, “控制包覆磁性材料之碳基奈米結構製程 (Process to control the magnetic alloys-encapsulated carbon nanostructure)”, 台灣發明專利 193587 號, 發明專利公報: 568883 號, 申請案號: 091137590。美國發明專利, 答辯中。

(f) 參與之主要計畫/技術：

計 畫 / 技 術 名 稱	產 品 應 用	執 行 期 間
金屬粉末射出成型製程技術	Metal parts	1991~1998
微細粉末製造與應用技術	Metal powder	1995~1998
金屬板片精密蝕刻技術	Shadow mask	1998~2001
OLED蒸鍍用金屬網罩製造技術	Metal mask	2001~2003
Dynode強化場發射顯示器核心技術與關鍵材料研究開發	CNT-FED	2003~2005
太陽能電池用矽材料純化技術	Solar cell	2005~2006